

Silicon PIN Diode

BA885

50V / 50mA

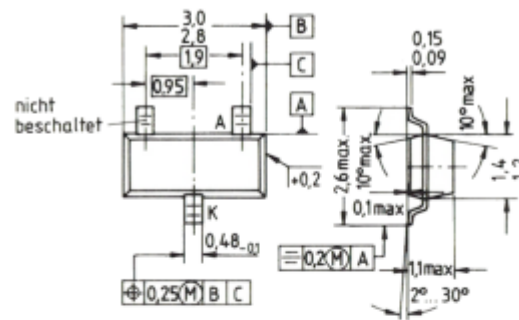
DATASHEET

OEM – Siemens

Source: Siemens Databook 1986/87

Silizium-PIN-Diode**BA 885****Vorläufige Daten**

- Stromgesteuerter HF-Widerstand
- Nutzbarer Frequenzbereich:
1 MHz ... 2 GHz
- Besonders geeignet als Polarisations-
schalter in TV-SAT-Tunern
- Kunststoff-Miniaturgehäuse
für Oberflächenmontage (SMD)

SOT 23

Typ	BA 885	
Best.-Nr.	Schüttgut: Q62702-A742	Gurt: Q62702-A608
Stempel	PA	

Grenzdaten

Sperrspannung	V_R	50	V
Durchlaßstrom	I_F	50	mA
Betriebstemperatur	T_{op}	100	°C
Lagertemperatur	T_{stg}	-65... +150	°C

Wärmewiderstand

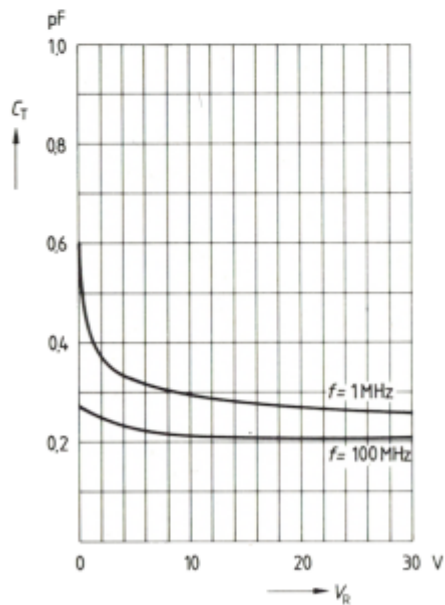
Sperrschicht-Umgebung	$R_{th,JA}$	≤ 450	K/W ¹⁾
-----------------------	-------------	------------	-------------------

¹⁾ Bei Montage auf Al_2O_3 -Keramiksubstrat 16,7 mm × 15 mm × 0,7 mm.

BA 885**Kenndaten** ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

		min	typ	max	
Durchlaßspannung $I_F = 50\text{ mA}$	V_F	—	—	1,1	V
Sperrstrom $V_R = 30\text{ V}$	I_R	—	—	50	nA
Diodenkapazität $V_R = 10\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $0\text{ V}, 100\text{ MHz}$	C_T		0,3 0,23	— 0,5	pF pF
Flußwiderstand, $f = 100\text{ MHz}$ $I_F = 1,5\text{ mA}$ 10 mA	r_f	—	22 5	40 7	Ω Ω
Sperrleitwert $V_R = 0, f = 100\text{ MHz}$	g_p	—	70	—	μS

Diodenkapazität $C_T = f(V_R)$
 $f = 1\text{ MHz}/100\text{ MHz}$



Flußwiderstand $r_f = f(I_F)$
 $f = 100\text{ MHz}$

